

ТРАНЗИСТОРЫ

Тип	Аналог	Технология	$P_{кmax}, Вт$	$U_{кэ max}, В$	$I_{к max}, А$	$h_{21Э}$	$U_{кэ нас.}$ не более, В	$I_{кбо}$ не более, А	$f_{гр}, МГц$	$t_{рас}$ не более, нс	Корпус	ТУ	
Транзисторные матрицы													
1НТ251	2N3903	4 п-р-п транзистора	0,4	45	0,4	30-150	1,0	0,006	-	100	401.14-6	И93.456.000ТУ	
1НТ251 ОС										И93.456.000ТУ /Д6 аА0.339.190 ТУ			
1НТ251А										И93.456.000ТУ			
1НТ251А ОС	2N3905	4 р-п-р транзистора				25-150	1,3	0,01		200		И93.456.000ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ	
2ТС622А										И93.456.001ТУ			
2ТС622А ОС										И93.456.001ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ			
2ТС622Б						И93.456.001ТУ							
2ТС622Б ОС						И93.456.001ТУ/Д6 аА0.339.190 ТУ							
Радационно-стойкие транзисторные сборки													
1НТ251А2	-	4 п-р-п транз.	0,4	45	0,4	80-350	1,0	0,015	-	200	401.14-6	И93.456.000ТУ/Д1	
1НТ251А2 ОС	-					И93.456.000ТУ/Д1 аА0.339.190 ТУ							
2ТС622А1	2N3905	4 р-п-р транз.				70-350	1,3	0,03				И93.456.001ТУ/Д1	
2ТС622А1 ОС												И93.456.001ТУ/Д1 аА0.339.190 ТУ	

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ

401.14-6

